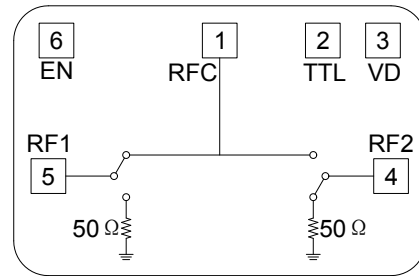


特点：

- 吸收式 SP2T 开关
- 频率：DC~4GHz
- 插入损耗：1.2dB
- 隔离度：70dB
- 工作温度：-55~+85℃
- 芯片尺寸：1.4×1.25×0.1mm

功能框图



性能参数：(T_A=+25℃, V_{Ctrl}=0/+5V)

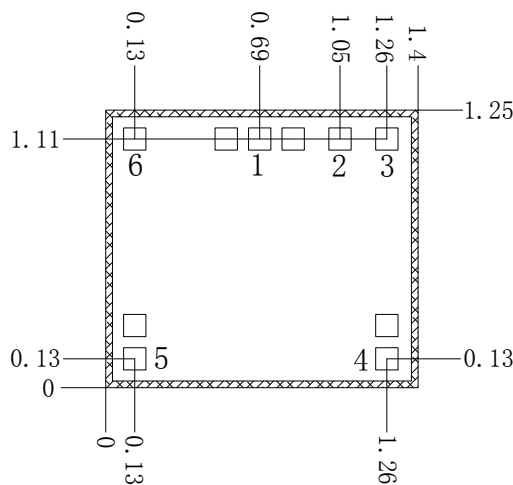
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
频率范围	f	Z _{in} =Z _{out} =50Ω P _{in} = 0dBm VD=+5V V _{Ctrl} =0/+5V	DC		4	GHz	
插入损耗	IL			1.2	2	dB	
隔离度	ISO		50	70		dB	
输入驻波	VSWR _i			1.4	2		
输出驻波	VSWR _o			1.4	2		
输入 P ₋₁	P ₋₁		15	30		dBm	
输入 IP3	IP3		30	45		dBm	
开关时间	t			70		ns	

极限参数表：

参数名称	极限值	单位	参数名称	极限值	单位
最大输入电压	+6	V	最大输入功率	+30	dBm
控制电压	低电平：0~0.2	V	贮存温度	-55~+150	℃
	高电平：4.5~5.5				

芯片尺寸图：

单位：mm



注：典型键合焊盘尺寸为 100*100um

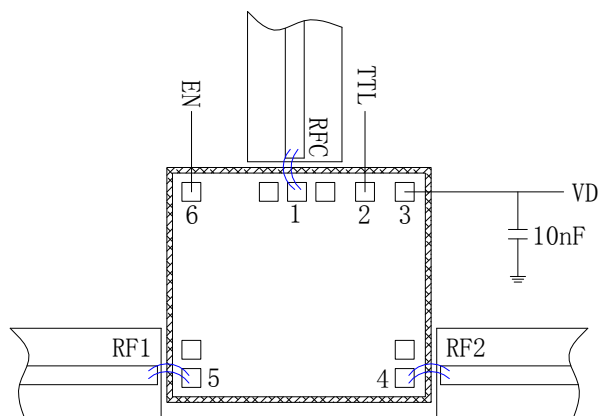
引脚定义：

引脚	定义	描述
1	RFC	射频输入，DC 耦合,需外接隔直电容
4, 5	RF2, RF1	射频输出，DC 耦合,需外接隔直电容
2	TTL	开关控制端
3	VD	TTL 驱动电路电源端，接+5V 电源，需外接 10nF 旁路电容
6	EN	开关芯片使能端
芯片背面	GND	芯片背面必须接至 RF/DC 地

真值表：(0: 0V, 1: +5V)

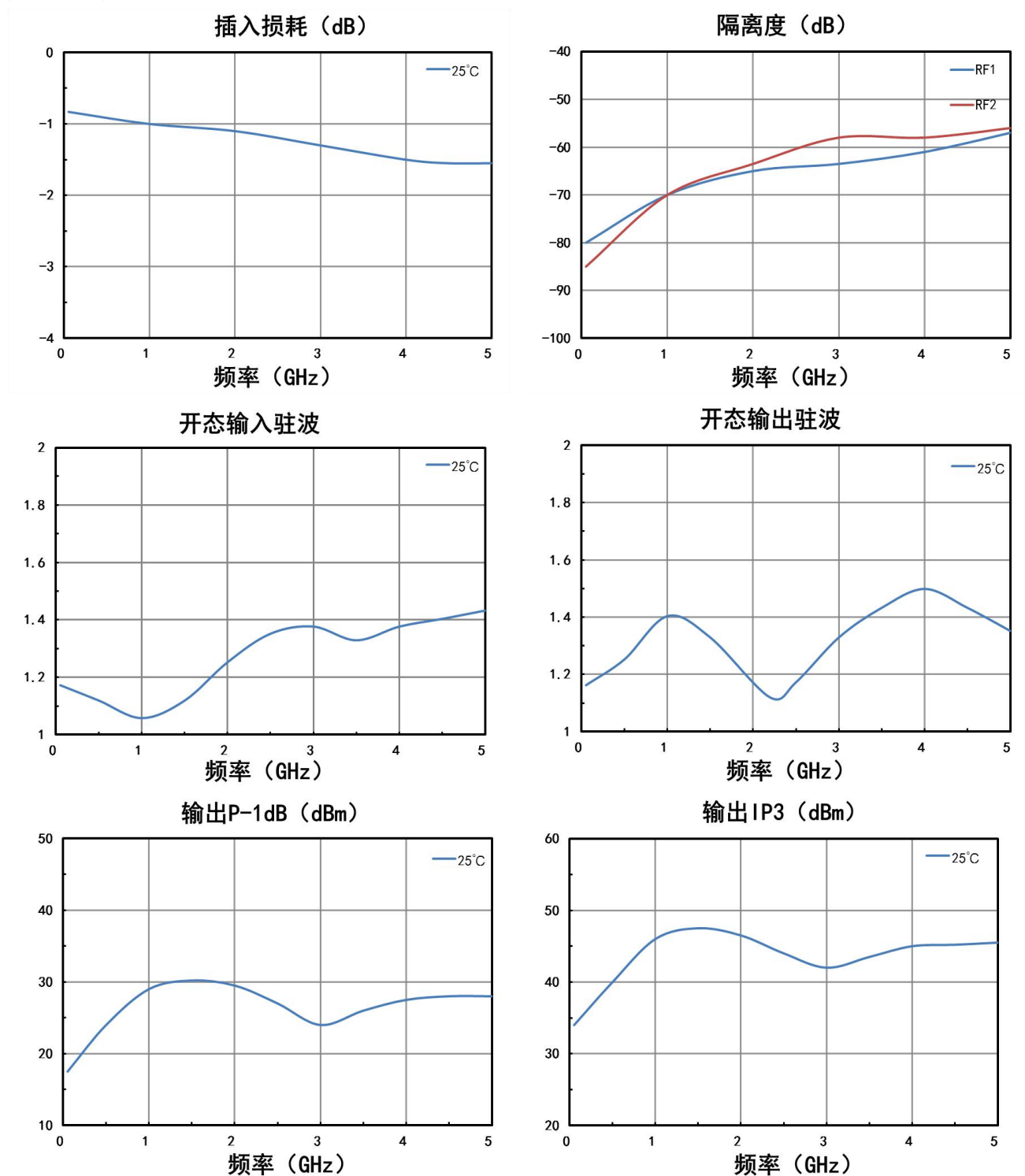
控制输入		通断状态	
EN	TTL	RFC-RF1	RFC-RF2
0	0	OFF	ON
1	0	ON	OFF
0	1	OFF	OFF
1	1	OFF	OFF

推荐装配图：



注：未标注的键合焊盘不需要连接

典型测试曲线：



产品使用注意事项：

1. 本芯片产品需要在干燥、氮气环境中存储，在超净环境装配使用；
2. 裸芯片使用的 GaAs 材料较脆，芯片表面容易受损，不能用干或湿化学方法清洁芯片表面使用时必须小心；
3. 芯片底部用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 295℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；

4. 芯片微波端口与微带线间歇不超过 3 mil，使用 1 mil 双金丝键合，其他端口使用 1 mil 单金丝，建议金丝长度 10~16 mil；
5. 产品对静电敏感，在存储和使用过程中注意防静电；
6. 其他使用说明详见《裸芯片产品使用说明》。